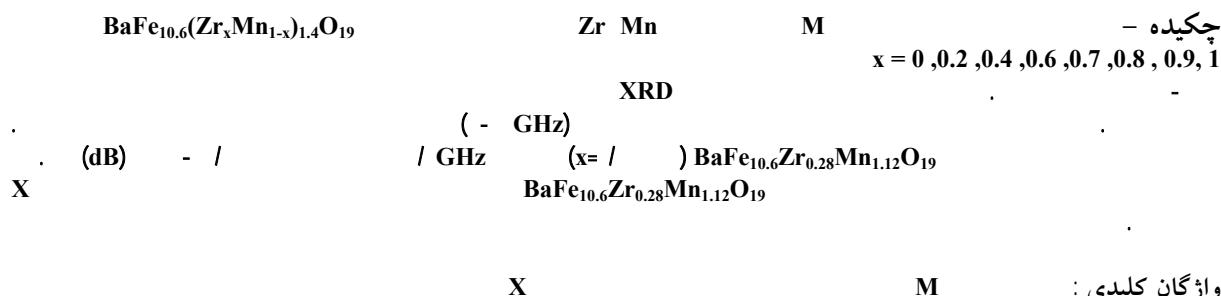


رفتار جذب امواج الکترومغناطیس در باند X در فریت باریم آلایده شده با Zr و Mn

عباس کیان وش و سمیرا دادستان*

دانشکده مکانیک-گروه مهندسی مواد، دانشگاه تبریز

(دریافت مقاله: ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ - دریافت نسخه نهایی: ۱۳۹۱/۰۵/۶)



واژگان کلیدی:

Investigation of EM Waves Absorbtion Behavior at X Band in Mn-Zr Doped Ba-Ferrite

A. Kianvash and S. Dadsetan

1. Department of Material Science and Engineering, Faculty of Mechanical Engineering,
University of Tabriz, Tabriz, Iran.

Abstract: In this research, M-type Mn-Zr doped Ba-ferrites powders with a general chemical composition of $BaFe_{10.6}(Zr_xMn_{1-x})_{1.4}O_{19}$ ($x = 0, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1$) were synthesized and prepared by a solid state method, and were then mixed with an Araldite + hardner and processed into polymer matrix composite specimens. Phase analyses of synthesized samples were performed by an XRD technique and magnetic properties of the composite specimens were measured using a hysteresis graph system. EM absorbtion characteristics of the composite samples in the (8-12 GHz) frequency ranges were determined using a VNA system. Among the compositions investigated in the present work, the highest absorbtion of -11.25 dB accured in $BaFe_{10.6}Zr_{0.28}Mn_{1.12}O_{19}$ ($x = 0.2$) at a frequency of 8.4 GHz. Based on EM absorbtion behaviors and magnetic properties, $BaFe_{10.6}Zr_{0.28}Mn_{1.12}O_{19}$ is classified as a potential EM absorber material.

*: مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: samira.dadsetan@gmail.com

Keywords: *M-type Ba-ferrite, Micro-wave, Electromagnetic wave absorbtion, X band*

امپدانس ورودی	Z_{in}	(MA/m) ناهمسان گردی بلوری مغناطیسی	H_A
ترواوایی مختلط مغناطیسی	μ_r	(cgs:Oe,SI:A/m) نیروی پسماند زدایی	H_{CJ}
ترواوایی مختلط الکتریکی	ϵ_r	(cgs:G,SI:T) مغناطش اشباع	J_S

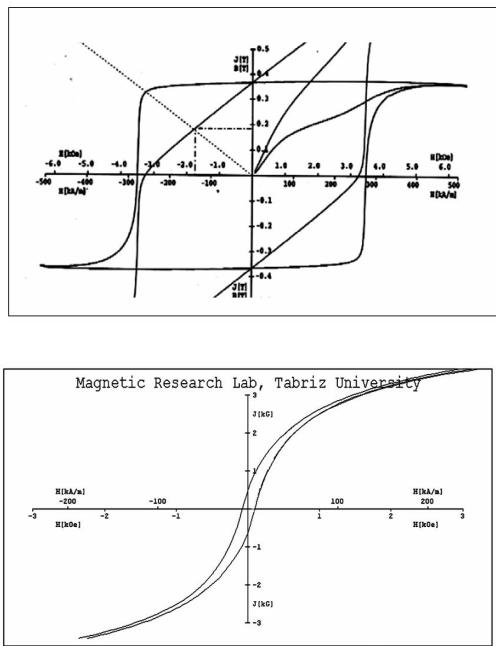
محدوده‌ی بسامدی رادار مطرح شود. در این کار پژوهشی فریت باریم آلاییده شده با Zr و Mn با فرمول کلی $BaFe_{10.6}(Zr_xMn_{1-x})_{1.4}O_{19}$ [۱۱] با $x = ۰/۰, ۰/۲, ۰/۴, ۰/۵, ۰/۶, ۰/۷, ۰/۸, ۰/۹$ به عنوان یک ترکیب شیمیایی بهینه با بالاترین میزان جذب امواج EM در محدوده‌ی باند X مورد مطالعه قرار گرفته است.

۲- مواد و روش تحقیق

برای تهییه ترکیبات با فرمول کلی $BaFe_{10.6}(Zr_xMn_{1-x})_{1.4}O_{19}$ از ایزی ۱، ۰/۹، ۰/۸، ۰/۷، ۰/۶، ۰/۵، ۰/۴، ۰/۲، ۰، $x = ۰/۰, ۰/۲, ۰/۴, ۰/۵, ۰/۶, ۰/۷, ۰/۸, ۰/۹$ ابتدا عملیات خردایش و اختلاط مواد اولیه شامل اکسید آهن، اکسید منگنز، اکسید زیرکونیوم و کربنات باریم، در یک آسیاب دورانی و در حضور استون انجام گرفت. درجه خلوص تمامی مواد مورد استفاده در حد ۹۹٪ بود. عملیات کلسینه کردن در دمای ۱۲۵۰°C به مدت زمان ۳ ساعت انجام و پس از آن نمونه‌ها مجدداً در یک آسیاب سیاره‌ای آسیاب شدند. نمونه‌های کامپوزیتی در مقطعی به ابعاد $22/86 \text{ mm} \times 10/16 \text{ mm}$ ، مطابق با اندازه‌ی مقطع موج بر باند بسامدی $8-12 \text{ GHz}$ ، از اختلاط پودر فریت باریم با رزین آرالдیت + سخت کننده پرس شدند. ضخامت تمامی نمونه‌های کامپوزیتی در اندازه ۶ mm ثابت نگه داشته شد اما در ترکیب با $x=۰/۲$ یعنی $BaFe_{10.6}Zr_{0.28}Mn_{1.12}O_{19}$ میزان جذب در

۱- مقدمه

در سال‌های اخیر تداخل امواج الکترومغناطیس، با توجه به کاربرد وسیع امواج الکترومغناطیس در محدوده بسامد GHz در تلفن‌های همراه، شبکه‌های محلی، سیستم‌های اختنایی رادار و غیره به عنوان یک مشکل جدی مطرح بوده و هست [۳-۱]. بنابراین استفاده از انواع جاذب‌های امواج میکروویو به عنوان پوشش روی تجهیزات الکترونیکی برای به حداقل رساندن تداخل الکترومغناطیسی و کمینه کردن برگشت امواج ضروری است [۶-۳]. فریت‌ها گروه مهمی از مواد مغناطیسی شامل اکسیدهای فلزی هستند و به عنوان مواد جاذب رادار به کار می‌روند. علت کاربرد گسترده فریت‌ها به عنوان RAM به دلیل تراوایی مغناطیسی بالا، مغناطش بالا و خواص دی الکتریک خوب آنها در بسامدهای میکروویو است [۶]. فریت‌های متداول شامل اسپینل‌ها، گارنت‌ها و فریت‌های هگزاگونال اند. در سال‌های اخیر توجه زیادی به فریت‌های هگزاگونال به عنوان مواد جاذب رادار شده است. یکی از انواع فریت‌های هگزاگونال، فریت باریم ($BaFe_{12}O_{19}$) است. میدان ناهمسان گردی (H_A) فریت باریم نوع M در حدود $1/36 \text{ MA/m}$ است و این ماده در بسامد $47/6 \text{ GHz}$ تشدید می‌شود، لذا این فریت نمی‌تواند در محدوده‌ی بسامدهای رادار (۸-۱۲ GHz) به عنوان یک جاذب عمل کند. با جانشینی یون‌های Ba^{+2} و Fe^{+3} مغناطش و ناهمسان گردی بلوری مغناطیسی این فریت اصلاح و تغییر در آن منجر به جابه‌جایی در بسامد تشدید آن می‌شود [۷-۱۰]. بدین ترتیب فریت مزبور می‌تواند به عنوان یک جاذب مؤثر در

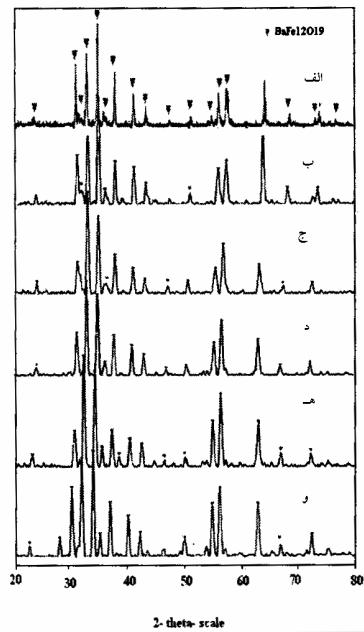


شکل ۲-(الف) فریت باریم آالاید نشده [۸] (ب) فریت باریم
آلاید شده با Zr و Mn

مقادیر $1, 0/5, 0/4, 0/2, 0$ به همراه الگوی XRD فریت باریم خالص نشان داده شده‌اند. همان‌طوری که مشاهده می‌شود تمامی نمونه‌های فریت آالاید شده دارای ساختمان‌های بلوری از نوع فریت باریم نوع M هستند. قله‌های موجود در نمونه‌های آالاید شده با Zr و Mn دقیقاً در محل قله‌های مربوط به فریت باریم خالص تشکیل شده‌اند و تنها تفاوت آنها در شدت قله‌های است که علت این امر را می‌توان به پرشدن برخی تنه‌جاهای احتمالی ناشی از فقدان یون Fe^{+3} موجود در شبکه هگزاگونال فریت باریم به همراه جایگزینی آن در این شبکه توسط یون‌های Zr و Mn ارتباط داد. لذا تصور می‌شود که هیچ فاز ثانویه‌ای ناشی از آالاید شدن فریت باریم خالص توسط یون‌های Zr و Mn تشکیل نشده است [۱۰۹].

۲-۳- خواص مغناطیسی

منحنی‌های هیسترزیس فریت باریم خالص و فریت باریم آالاید شده با ترکیب $\text{BaFe}_{10.6}\text{Zr}_{0.7}\text{Mn}_{0.7}\text{O}_{19}$ ($x=0/5$) در شکل (۲) مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. همچنانکه مشاهده



شکل ۱- الگوی پراش اشعه X (الف) فریت باریم خالص و نمونه‌های پودری ترکیب $\text{BaFe}_{10.6}(\text{Zr}_x\text{Mn}_{1-x})_{1.4}\text{O}_{19}$ با مقادیر (ب) $x=0/4$ ، (د) $x=0/2$ ، (ج) $x=0/1$ ، (ه) $x=0/5$

ضخامت‌های بین 2 تا 5 mm با یک بازه افزایشی $0/5$ mm نیز مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل فازی نمونه‌ها، توسط یک دستگاه اشعه X مدل زیمنس D5000، با اشعه $\text{K}\alpha$ مربوط به Cu، با ولتاژ 60 kV و جریان 30 mA انجام شد. ویژگی‌های مغناطیسی نمونه‌ها توسط یک دستگاه هیسترزیس گراف مدل Magnet Physik C-300 اندازه‌گیری شد و ویژگی جذب امواج الکترومغناطیس نمونه‌ها با استفاده از یک دستگاه تحلیلگر شبکه‌ی برداری (VNA) مدل HP 8410C صورت پذیرفت.

۳- نتایج و بحث

۳-۱- تحلیل فازی

در شکل (۱)، الگوهای پراش اشعه ایکس (XRD) نمونه‌های پودری ترکیب $\text{BaFe}_{10.6}(\text{Zr}_x\text{Mn}_{1-x})_{1.4}\text{O}_{19}$ با

عنوان جاذب عمل کنند [۱۴، ۱۲ و ۱۵].

۳-۳- ویژگی جذب امواج الکترومغناطیس

تلغات انعکاسی یک ماده جاذب با میزان امپدانس ورودی آن

طبق نظریه خطوط انتقال با فرمول زیر مشخص می‌شود :

$$R(\text{dB})=20 \log|Z_{\text{in}}-1)/(Z_{\text{in}}+1)| \quad (1)$$

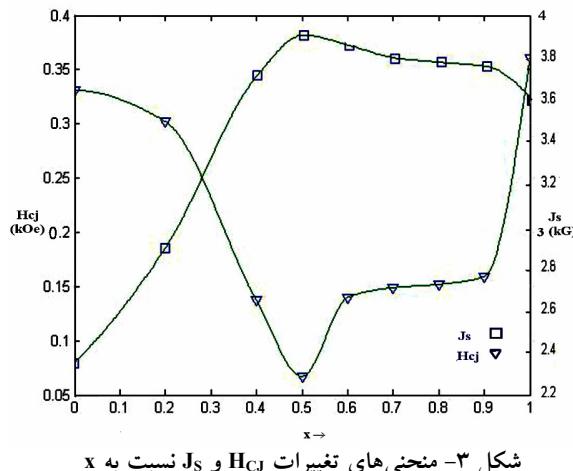
که توسط Z_{in} توسط معادله زیر به پارامترهای مغناطیسی ماده جاذب

ارتباط پیدا می‌کند :

$$Z_{\text{in}}=(\mu_r/\epsilon_r)^{(1/2)} \tanh[j(2\pi/C)(\mu_r \epsilon_r)^{(1/2)} f.d] \quad (2)$$

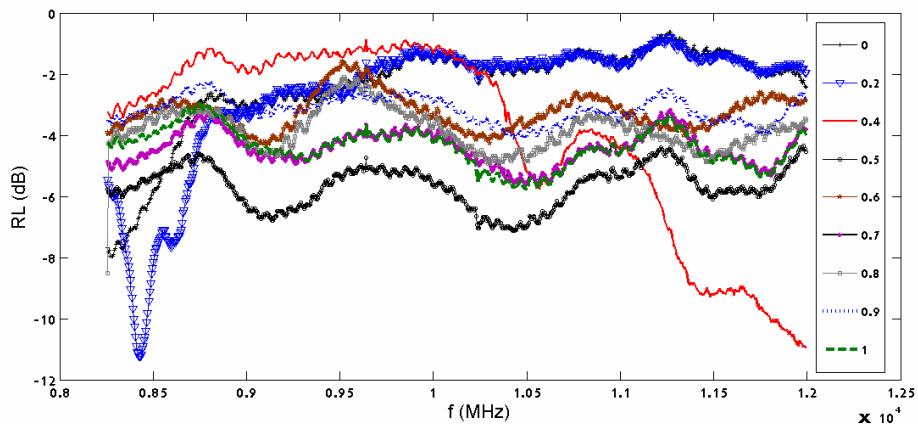
که در آن μ_r و ϵ_r به ترتیب تراوایی مختلط مغناطیسی و الکتریکی محیط جاذب، C سرعت نور در فضای آزاد، f بسامد و d ضخامت ماده جاذب است. در یک ماده جاذب ایدئال شرایط باید به گونه‌ای باشد که امپدانس ورودی برابر ۱ شود. فریت باریم خالص، به دلیل بالابودن بسامد تشدید در آن دارای جذب مناسبی در باند X نیست. آلایده این فریت با یون‌های مناسب، بسامد تشدید این ماده را کاهش و میزان جذب آن در باند X را افزایش می‌دهد [۱۳-۵].

نمودارهای میزان جذب انعکاسی با بسامد در نمونه‌های با ترکیب $\text{BaFe}_{10.6}(\text{Zr}_x\text{Mn}_{1-x})_{1.4}\text{O}_{19}$ ، به ازای مقادیر $x = 0/9, 0/8, 0/7, 0/6, 0/5, 0/4, 0/3, 0/2, 0/1$ در شکل (۴) نشان داده شده‌اند. ضخامت تمامی نمونه‌ها در این بررسی mm ۶ است. ترکیب $\text{BaFe}_{10.6}\text{Zr}_{0.7}\text{Mn}_{0.3}\text{O}_{19}$ (به ازای $x = 0/5$) در محدوده بسامدی باند X دارای گستره جذب انعکاسی وسیع تری نسبت به ترکیبات دیگر است ($7/67 \text{ dB}$). ترکیب $\text{BaFe}_{10.6}\text{Zr}_{0.28}\text{Mn}_{1.12}\text{O}_{19}$ به ازای $x = 0/2$ در بسامد $8/4 \text{ GHz}$ جذبی برابر $-11/24 \text{ dB}$ و ترکیب $\text{BaFe}_{10.6}\text{Zr}_{0.56}\text{Mn}_{0.84}\text{O}_{19}$ به ازای $x = 0/4$ از بسامد حدود $11/2 \text{ GHz}$ به بعد شروع به نشان دادن جذب بالاتر از خود می‌کند، بدین معنی که احتمال تشدید در این ترکیب در بسامدهای بالاتر و یا در ضخامت‌های دیگر وجود دارد. از آنجایی که ما بین نمونه‌های مورد بررسی در باند X جذب رزنانسی فقط در نمونه با $x = 0/2$ اتفاق افتاد، لذا نمونه

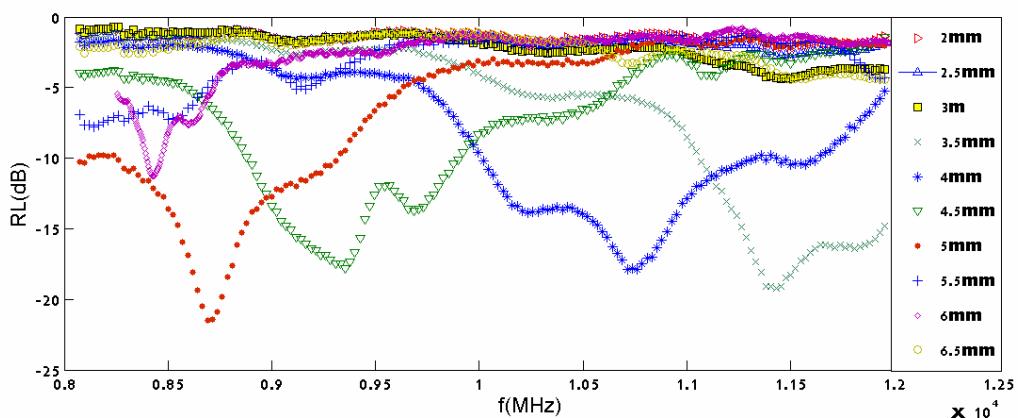


شکل ۳- منحنی‌های تغییرات H_{CJ} و J_s نسبت به x

می‌شود، نمونه فریت باریم خالص، شکل (۲-الف) از مرجع [۸] گرفته شده است، دارای یک نیروی پسماندزدایی بالاتری (در حدود $H_J = ۳/۵ \text{ kOe}$ در مقایسه با نیروی پسماندزدایی نمونه آلایده شده $۰/۰۶۷ \text{ kOe}$) است. بالابودن این پارامتر باعث می‌شود که فریت باریم خالص مانند یک ماده مغناطیسی سخت رفتار کند و لذا به صورت یک جاذب EM موثر در باند X عمل نکند. با جانشین سازی یون‌های Mn و Zr در فریت باریم، نیروی پسماندزدایی نسبت به نیروی پسماندزدایی فریت باریم خالص کاهش می‌یابد. دلیل این کاهش، به افت ناهمسانگردی بلوری مغناطیسی و تغییرجهت آسان مغناطش از محور ۳، در ساختمان بلوری شش وجهی فریت باریم به صفحه موازی با صفحه قاعده آن (ناهمسانگردی صفحه‌ای) در فریت باریم آلایده شده ارتباط داده شده است [۱۴، ۱۲ و ۱۵]. منحنی‌های تغییرات H_{CJ} و J_s (مغناطش اشباع) نسبت به x در شکل (۳) نمایش داده شده‌اند. با افزایش مقدار x تا $0/5$ H_{CJ} نمونه‌ها کاهش J_s آنها افزایش و مجدداً با افزایش آن تا $x = 1$ H_{CJ} و J_s کاهش می‌یابند. مقدار متوسط H_{CJ} در نمونه‌های مذکور نشان می‌دهد که مکانیزم غالب جذب امواج EM در نمونه‌های فریتی آلایده شده حرکت دیواره حوزه‌های مغناطیسی است، لذا هر قدر نمونه‌های مذکور از نظر مغناطیسی نرم تر و J_s آنها بالاتر باشد، به همان اندازه بهتر می‌توانند به



شکل ۴- منحنی های تغییرات جذب نسبت به بسامد در نمونه های کامپوزیتی با ترکیب کالی $BaFe_{10.6}(Zr_xMn_{1-x})_{1.4}O_{19}$ به ازای x های مختلف



شکل ۵- منحنی های تغییرات جذب نسبت به بسامد در نمونه های کامپوزیتی با ترکیب شیمیابی $BaFe_{10.6}Zr_{2.8}Mn_{3.2}O_{19}$ در ضخامت های متفاوت

توجهی مشاهده نشد. لذا پیش بینی می شود که ترکیب $BaFe_{10.6}Zr_{0.28}Mn_{1.12}O_{19}$ (به ازای $x = 0/2$) با کترل ضخامت نمونه، می تواند به عنوان یک جاذب خوب در باند X عمل کند.

۴- نتیجه گیری

1. طبق نتایج XRD، با آلاییدن فریت باریم توسط کاتیون های Zr و Mn ، این کاتیون ها به جای Fe در شبکه بلوورین فریت قرار می گیرند، در نتیجه هیچ فاز ثانویه ای ناشی از آالیش فریت با کاتیون های مذکور به وجود نمی آید.

کامپوزیتی این ترکیب در ضخامت های متفاوت نیز مورد بررسی قرار گرفت. شکل (۵) تغییرات جذب انعکاسی نسبت به بسامد در این ترکیب در نمونه های به ضخامت های مختلف بین ۲ تا $6/5$ mm، در یک بازه افزایشی $0/5$ mm را نشان می دهد. مابین ضخامت های مورد بررسی، ترکیب مذکور فقط در ضخامت های $4/5$ ، $3/5$ و 5 mm به ترتیب در بسامدهای $10/7$ GHz، $11/4$ GHz، $-17/88$ dB، $-19/2$ dB، $-21/49$ dB، $8/6$ GHz، $-17/87$ dB، $9/3$ GHz رزنانسی از خود نشان داد. در بقیه ضخامت ها، جذب EM قابل

۴. بیشترین مقدار جذب رزنانس در بسامد $8/6$ GHz ، در ترکیب به ازای $x=0/2$ ، در نمونه‌ای با ضخامت 5 mm انفاق افتاد که حدود $21/49$ dB - بود.
۵. با این که در کل، با کاهش H_{CJ} و افزایش J_S میزان جذب در نمونه‌ها اصلاح شد، اما در پژوهش حاضر، بهترین ترکیب (یعنی $BaFe_{10.6}Zr_{0.28}Mn_{1.12}O_{19}$ به ازای $x=0/2$) متناظر با H_{CJ} کمینه و J_S بیشینه (متعلق به $x=0/5$) نبود.
۶. با جایگزین کردن Mn و Zr به جای Fe در فریت باریم نوع M ($BaFe_{12}O_{19}$)، در مقایسه با فریت باریم خالص، H_{CJ} به طور موثر کاهش و J_S به طور نسبی افزایش می‌یابد.
۷. در نمونه به اضافه خامات 6 mm، در ترکیب $BaFe_{10.6}(Zr_xMn_{1-x})_{1.4}O_{19}$ به ازای $x=0/2$ ، پدیده رزنانس در محدوده باند X انفاق افتاد (در بسامد $8/4$ GHz با جذبی برابر $11/24$ dB) و به ازای $x=0/5$ علی‌رغم عدم قوعه پدیده رزنانس، جذب یکنواختی در حدود

واژه نامه

1. EM
2. VNA: vector network
3. LAN: local area network
4. RAM: radar absorbing materials

مراجع

1. Huo., Jia Wang., L., and Yu., H., "Polymeric Nanocomposites for Electromagnetic Wave Absorption," *Journal of Mater Sci*, Vol. 44, pp. 3917–3927, 2009.
2. Jae-Man, S., Hyun-Jin, Y., Dong-Il, K., Su-Jung, K., Seung-Min, O., Bo-Young, K., Ki-Man, K., and Young-Goo, L., "Dependence of Electromagnetic Wave Absorption on Ferrite Particle Size in Sheet-Type Absorbers," *Journal of the Korean Physical Society*, Vol. 42, pp. 671-675, 2003.
3. Özgür, U., Alivov, Y., and Morkoç, H., "Microwave Ferrites, Part 1: Fundamental Properties," *Journal of Materials Science*, Part 1: Fundamental Properties, 2009.
4. Singh, P., Babbar, V.K., Razdan, A., Srivastava, S.L., Agrawal, V.K., and Goel, T.C., "Dielectric Constant, Magnetic Permeability and Microwave Absorption Studies of Hot-Pressed Ba-CoTi Hexa-Ferrite Composites in X-Band," *Journal of Mater Sci*, Vol. 41, pp. 7190–7196, 2006.
5. Tang, X., and Yang,Y., "Surface Modification of M-Ba-Ferrite Powders by Polyaniline: Towards Improving Microwave Electromagnetic Response," *Applied Surface Science*, Vol. 255,pp. 9381–9385, 2009.
6. Zhang, B., Feng, Y., Xiong, J., Yang, Y., and Lu, H., "Microwave-Absorbing Properties of De-Aggregated Flake-Shaped Carbonyl-Iron Particle, " *IEEE Transactions on Magnetics*, Vol. 42, pp.1778-1781, 2006.
7. Meshram, M. R., Agrawal, N. K., Sinha, B., and Misra, P. S., "Characterization of M-type Barium Hexagonal Ferrite-based Wide Band Microwave Absorber," *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, Vol. 271, pp. 207–214, 2004.
8. Shams, M. H., Salehi, S.M.A., and Ghasemi, A., "Electromagnetic Wave Absorption Characteristics of Mg-Ti substituted Ba-hexaferrite," *Materials Letters*, Vol. 62, pp. 1731–1733, 2008.
9. Paul, K. B., "Magnetic and Structural Properties of Ba M-Type Ferrite-Composite Powders," *Physica*, Vol. 388, pp. 337–343, 2007.
10. Shin, J. Y., and Oh, J. H., "The Microwave Absorbing Phenomena of Ferrite Microwave Absorbers," *IEEE Transactions on Magnetics*, Vol. 29, pp. 3437-3439, 1993.
11. Kagotani, T., Fujiwara, D., Sugimoto, S., Inomata, K., and Homma, M., "Enhancement of GHz Electromagnetic Wave Absorption Characteristics in Aligned M-Type Barium Ferrite $Ba_{1-x}LaxZnxFe_{12-x-y}(Me0.5Mn0.5)yO_{19}$ ($y = 1-3$, $x=0-0.5$; Me: Zr, Sn) by Metal Substitution," *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, Vol. 272-276, pp. 1813-1815, 2004.
12. Ghasemi, A., Hossienpour, A., Morisako, A., Saatchi, A., and Salehi, M., "Electromagnetic Properties and Microwave Absorbing Characteristics of Doped Barium Hexaferrite," *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, Vol. 302, pp. 429–435, 2006.
13. Ghasemi, A., and Morisako, A., "Static and High Frequency Magnetic Properties of Mn-Co-Zr

- Substituted Ba-Ferrite,”*Journal of Alloys and Compounds*, Vol. 456, pp. 485–491, 2008.
14. Ghasemi, A., Hossienpour, A., Morisako, A., Liu, X., and Ashrafizadeh, A., “Investigation of the Microwave Absorptive Behavior of Doped Barium Ferrites,” *Materials and Design*, Vol. 29, pp. 112–117, 2008.
15. Shuang, V., “Magnetic Anisotropy and Coercivity in Magnetic Thin Films,” a Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science, Singapore, 2000.